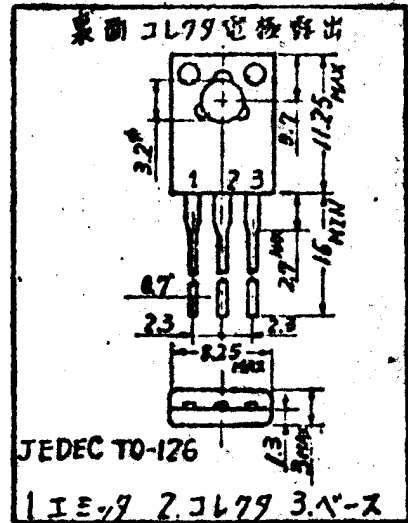


# FUJITSU TRANSISTOR

## 2SC2028/2

2SC2028/2 は高周波電力増幅用 (27MHz 2W 出力, 5W class のドライバー等) として設計された NPN エピタキシャル・プレーナ形シリコン・トランジスタです。

### 外形寸法および電板接続



### 最大定格

周囲温度  $T_a=25^\circ\text{C}$

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	80	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	6	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	50	V
コレクタ電流	$I_C$	1.5	A
コレクタ損失	$P_C$	1	W
コレクタ損失	$P_C$	5*	W
接合部温度	$T_j$	+150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150	$^\circ\text{C}$

\* $T_C=25^\circ\text{C}$

### 電気的特性

周囲温度  $T_a=25^\circ\text{C}$

項目	記号	条件	規格			単位
			最小値	標準値	最大値	
コレクタ・しや断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=30\text{ V}, I_E=0$			1	$\mu\text{A}$
エミッタ・しや断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=4\text{ V}, I_C=0$			1	$\mu\text{A}$
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	$I_{CB}=0.1\text{ mA}, I_E=0$	80			V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	$I_{EB}=0.1\text{ mA}, I_C=0$	6			V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	$I_{CE}=2\text{ mA}, I_B=0$	50			V
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE}=5\text{ V}, I_C=100\text{ mA}$	90		320	-
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500\text{ mA}, I_B=50\text{ mA}$			0.5	V
しや断周波数	$f_T$	$V_{CE}=5\text{ V}, I_C=100\text{ mA}$		250		MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=10\text{ V}, I_E=0, f=1\text{ MHz}$		18	40	pF
出力電力	$P_{out}$	$f=27\text{ MHz}, V_{CC}=12\text{ V}, P_{in}=30\text{ mW}$	0.5	0.7		W